

SMD-12866

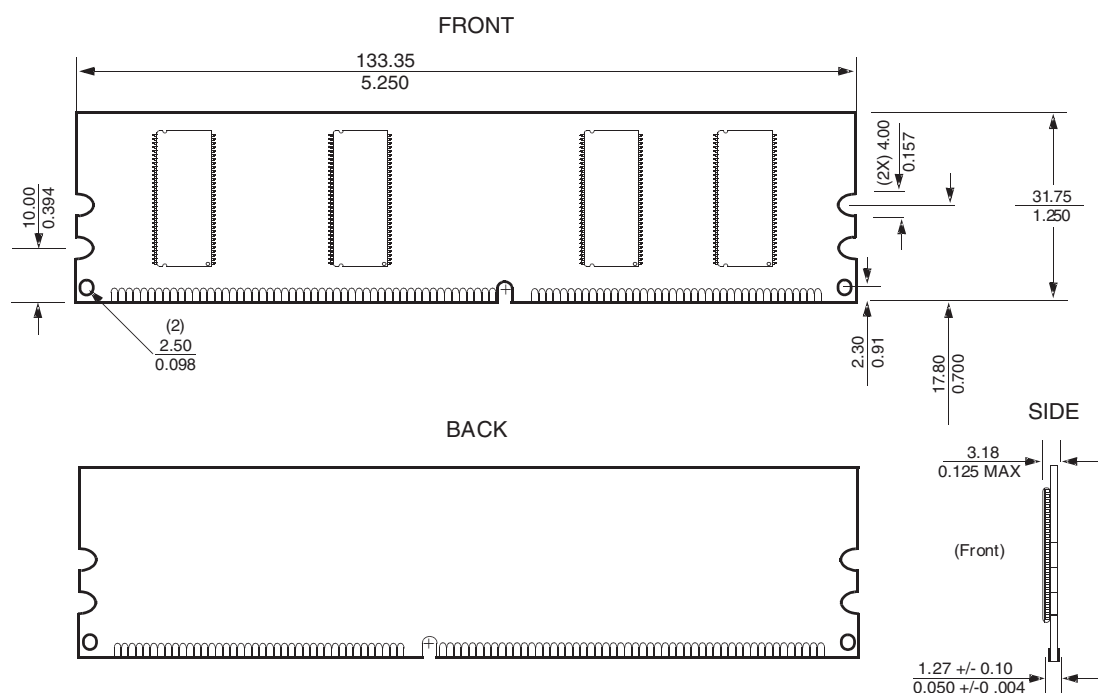
DESCRIPTION

SMD - 1 2 8 6 6 は、2 5 6 MビットDDR・DRAM (16M x 16bit) を4個搭載した1 6 M x 6 4 ビットDDR・DRAMモジュールです。

FEATURES

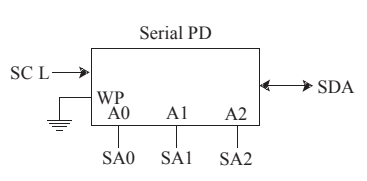
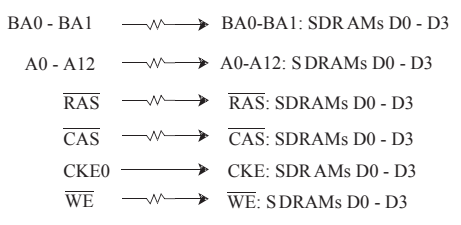
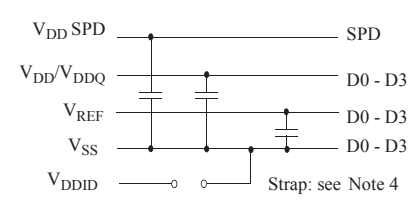
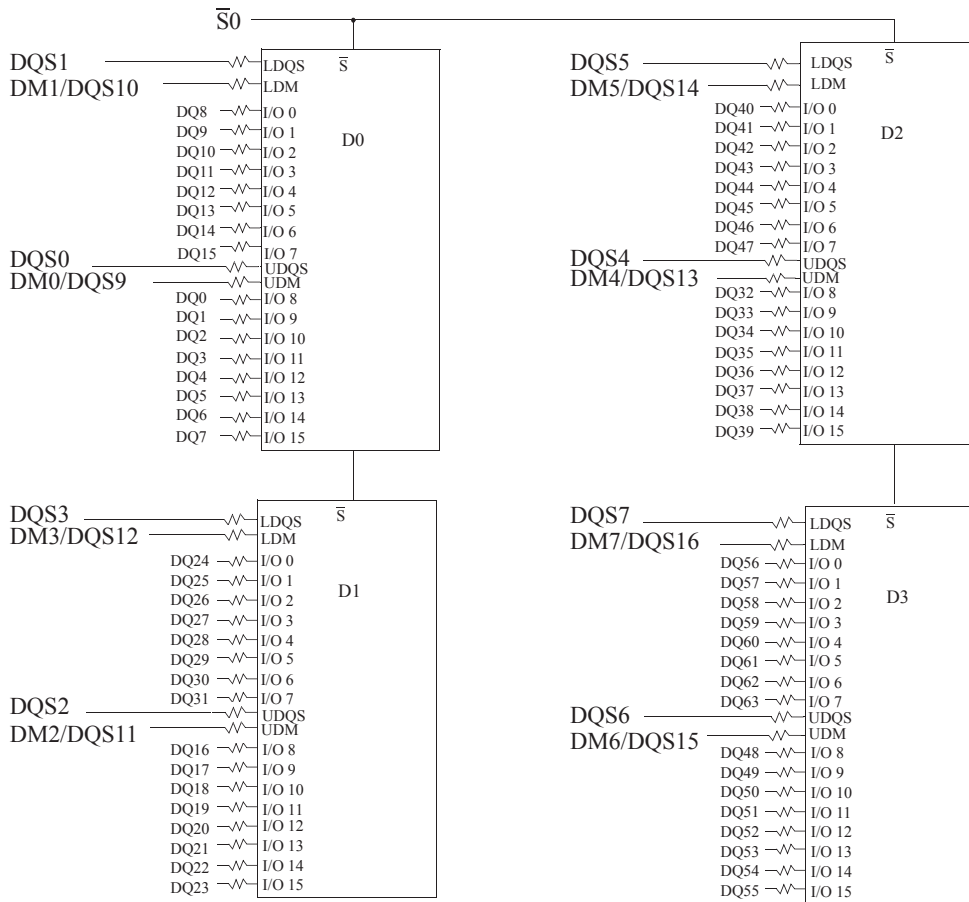
- ・ 1 8 4 ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール
(ピン・ピッチ 1.27mm)
- ・ 基板高 1.25 "(31.75mm)
- ・ CL - tRCD - tRP=3 - 3 - 3 (PC3200) 2.5 - 3 - 3 (PC2700 / PC2100)
- ・ 2.6V ± 0.1V 単一電源 (PC3200) 2.5V ± 0.2V (PC2700 / PC2100)
- ・ 8, 192リフレッシュ / 64ms
- ・ SSTL_2コンパチブル
- ・ /CASレイテンシー3.0, 2.5, 2.0クロックプログラマブル (PC3200)
- ・ " 2.5, 2.0クロックプログラマブル (PC2700 / PC2100)
- ・ 1バンク構成
- ・ アンバッファードタイプ
- ・ シリアルPD
- ・ 接続端子：電解金メッキ (t 0.76 μm)

Outline Drawing



Note: All dimensions are typical unless otherwise stated $\frac{\text{millimeters}}{\text{inches}}$

Functional Block Diagram



* Clock Wiring	
Clock Input	SDRAMs
*CK0/CK0	NC
*CK1/CK1	2 SDRAMs
*CK2/CK2	2 SDRAMs

* Wire per Clock Loading Table/ Wiring Diagrams

- Notes:**
- DQ-to-I/O wiring is shown as recommended but may be changed.
 - DQ/DQS/DM/CKE/S relationships must be maintained as shown.
 - DQ, DQS, DM/DQS resistors: 22 ohms ± 5%.
 - V_{DDID} strap connections
(for memory device V_{DD} , V_{DDQ}):
STRAP OUT (OPEN): $V_{DD} = V_{DDQ}$
STRAP IN (V_{SS}): $V_{DD} \neq V_{DDQ}$
 - BAx, Ax, \overline{RAS} , \overline{CAS} , \overline{WE} resistors: 7.5 ohms ± 5% (Except PC2100)